



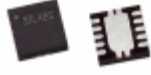
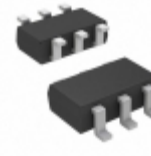




	<h2 style="color: #C00000;">SI3460DV-T1-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI3460DV-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 5.1A 6TSOP
	Datenblätter:  SI3460DV-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 236971 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3460DV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 5.1A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	236971 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 5.1A (Ta) 1.1W (Ta) Surface Mount 6-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27 mOhm @ 5.1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 1mA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3460DV-T1-E3DKR

SI3460DV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3460DV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3460DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3460DV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3460DDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 7.9A 6-TSOP</p>	 <p>SI3461-E01-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC POWER MANAGEMENT CTLR 11VQFN</p>	 <p>SI3461-E01-GMR Energy Micro (Silicon Labs) IC POWER MANAGEMENT CTLR 11VQFN</p>	 <p>SI3460DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 5.1A 6TSOP</p>
 <p>SI3460DDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 7.9A 6-TSOP</p>	 <p>SI3460DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 5.1A 6TSOP</p>	 <p>SI3460DDV-T1-E3 Son Son TSOP-6</p>	 <p>SI3460DV-T1 VISHAY SI3460DV-T1 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

SI3458BDV-T1-E3	SI3458BDV-T1-GE3	SI3458BDV-T1-GE3	SI3458DV-T1-E3	SI3458DV-T1-E3
SI3458DV-T1-GE3	SI3459BDV-T1-E	SI3459BDV-T1-E3	SI3459BDV-T1-E3	SI3459BDV-T1-GE3
SI3459BDV-T1-GE3	SI3459DV-T1-E3	SI3459DV-T1-E3	SI3459DV-T1-GE3	SI3460-E02-GMR
SI3460-E03-GMR	SI3460BDV-T1-E3	SI3460BDV-T1-E3	SI3460BDV-T1-GE3	SI3460BDV-T1-GE3
SI3460DDV	SI3460DDV-T1-GE3	SI3460DDV-T1-GE3	SI3460DV	SI3460DV-T1
SI3460DV-T1-E3	SI3460DV-T1-GE3	SI3460DV-T1-GE3	SI3461DV-T1-E3	SI3461DVT1-GE3
SI3464DV	SI3464DV-T1-GE3	SI3464DV-T1-GE3	SI3465DV-T1-E3	SI3465DV-T1-E3
SI3465DV-T1-GE3	SI3465DV-T1-GE3	SI3467DV	SI3467DV-T1-E3	SI3467DV-T1-E3
SI3467DV-T1-GE3	SI3467DV-T1-GE3	SI3469DV-T1	SI3469DV-T1-E3	SI3469DV-T1-E3
SI3469DV-T1-GE3	SI3469DV-T1-GE3	SI3471DV-T1-E3	SI3473CDV-T1-E3	SI3473CDV-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited